

研究指向型KMUTT受入gPBL

実施期間	実施国	共同実施機関	対象	参加者	本学担当教員
2026年07月30日 ～2026年08月07日	日本	キングモンクット工科大学 ンプリ校	・電子工学科、先端電子工学 コース ・学部3年生、学部4年生、学 部2年生、学部1年生	(芝浦工業大学) 学生8名、学生バイト6名、 教員1名 (キングモンクット工科大学 ンプリ校) 学生10名、教員2名	横井 秀樹(電気電子工学課 程先端電子工学コース)



図1 実習の様子

電気電子工学課程、先端電子工学コースの受入型グローバルPBLとして、ナノエレクトロニクス・フォトリソグラフィ分野における実習活動に、タイのキングモンクット王立工科大学(KMUTT)の学生と本学の学生が共同で取り組んだ。ナノエレクトロニクス・フォトリソグラフィ分野の最先端の研究に触れるとともに、他国の学生との共同作業を通じて様々な価値観を学ぶことがgPBLの目的である。今年度は、本学の学生2名、KMUTTの学生2～3名で4つのグループを構成し、参加教員の研究室において研究分野の現状について学び、基礎的な実験及び発展的な内容の実験を行い、得られた結果について考察した。最後に、実習活動で得られた知見について、グループ毎にプレゼンテーションを行った。実習活動は、集積光デバイス研究室(光波に関する実験、光学材料・光ファイバに関する実験等)で実施した。



図2 屈折の実験



図3 光伝搬の実験



図4 浴衣イベント